

Silicon Power Schottky Diode

$V_{RRM} = 20 \text{ V} - 100 \text{ V}$

$I_F = 400 \text{ A}$

Features

- High Surge Capability
- Types up to 100 V V_{RRM}
- Isolation Type Package

Three Tower Package



Maximum ratings, at $T_j = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified ("R" devices have leads reversed)

Parameter	Symbol	Conditions	MBRT40045 (R)	MBRT40060 (R)	MBRT40080 (R)	MBRT400100 (R)	Unit
Repetitive peak reverse voltage	V_{RRM}		45	60	80	100	V
RMS reverse voltage	V_{RMS}		32	42	57	70	V
DC blocking voltage	V_{DC}		45	60	80	100	V
Continuous forward current	I_F	$T_C \leq 100^\circ\text{C}$	400	400	400	400	A
Surge non-repetitive forward current, Half Sine Wave	$I_{F,SM}$	$T_C = 25^\circ\text{C}$, $t_p = 8.3 \text{ ms}$	3000	3000	3000	3000	A
Operating temperature	T_j		-40 to 150	-40 to 150	-40 to 150	-40 to 150	$^\circ\text{C}$
Storage temperature	T_{stg}		-40 to 175	-40 to 175	-40 to 175	-40 to 175	$^\circ\text{C}$

Electrical characteristics, at $T_j = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Conditions	MBRT40045 (R)	MBRT40060(R)	MBRT40080 (R)	MBRT400100 (R)	Unit
Diode forward voltage	V_F	$I_F = 200 \text{ A}$, $T_j = 25^\circ\text{C}$	0.75	0.8	0.88	0.88	V
Reverse current	I_R	$V_R = 20 \text{ V}$, $T_j = 25^\circ\text{C}$	1	1	1	1	mA
		$V_R = 20 \text{ V}$, $T_j = 125^\circ\text{C}$	20	20	20	20	

Thermal characteristics

Thermal resistance, junction - case	R_{thJC}		0.14	0.14	0.14	0.14	$^\circ\text{C/W}$
-------------------------------------	------------	--	------	------	------	------	--------------------

Figure .1- Typical Forward Characteristics

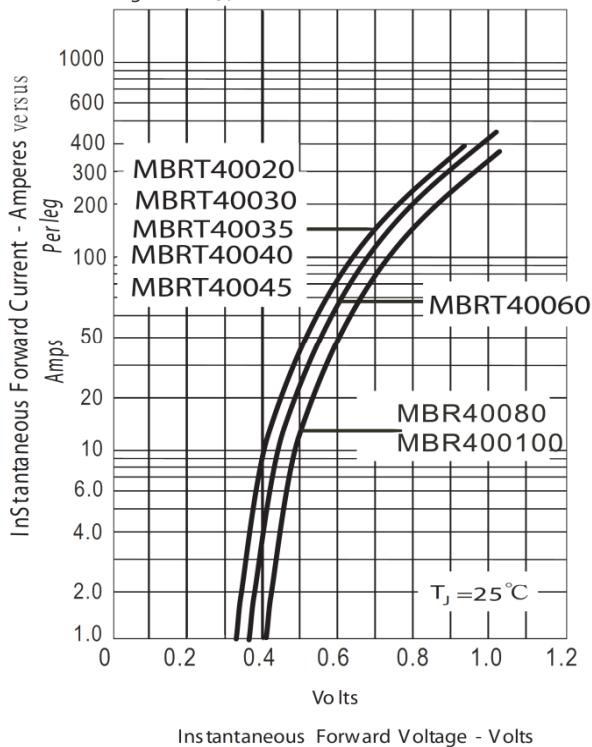


Figure .2- Forward Derating Curve

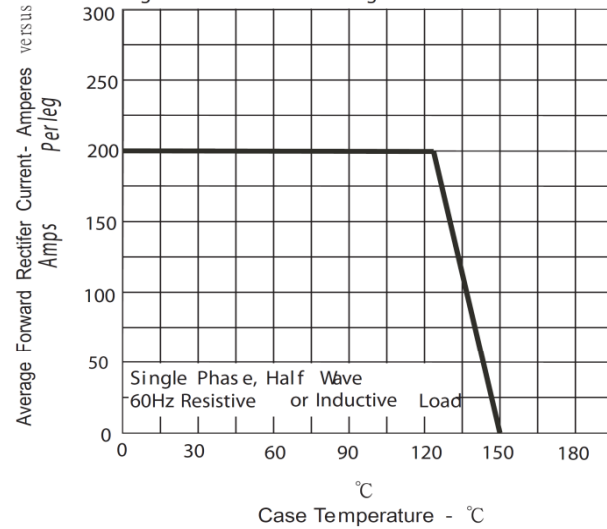


Figure.3-Peak Forward Surge Current

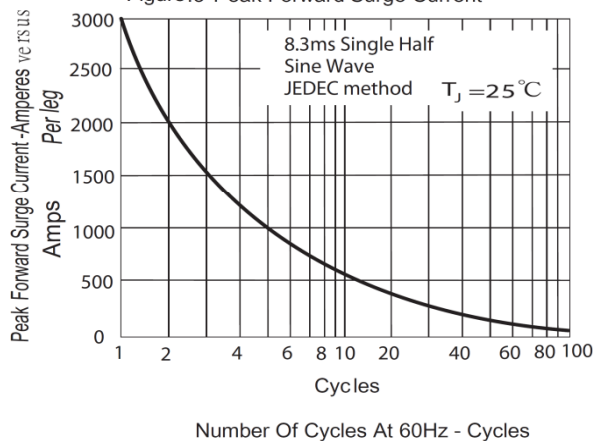
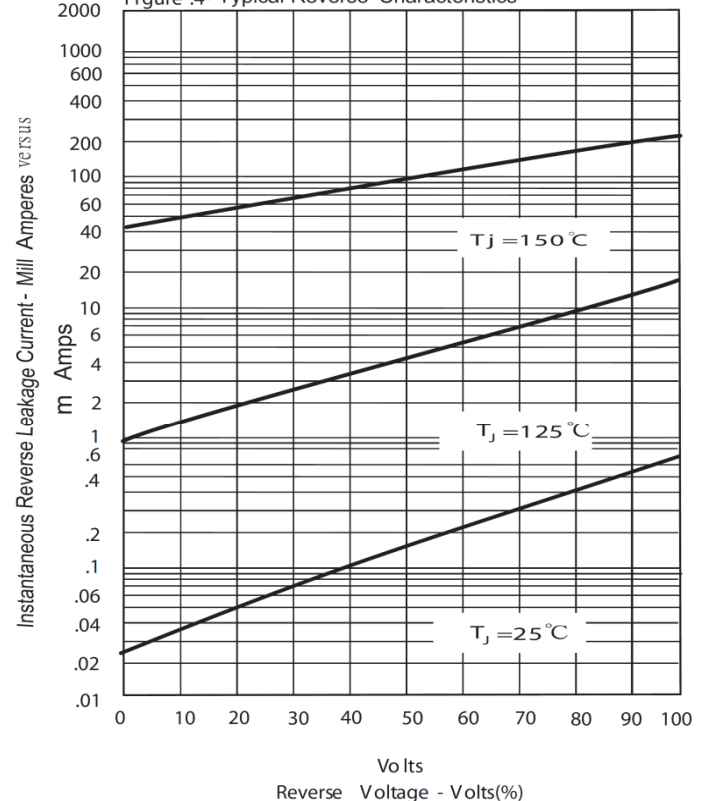


Figure .4- Typical Reverse Characteristics



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9